

Vol. 17, No. 4, Winter 1388/2010



# The effect of temperature and annealing on the structural properties of CdS: Mn semiconductor nanocrystals

## S. Salimian<sup>\*</sup>, S. Farjami Shayesteh

Nanostructure Laboratory, Department of Physics, University of Guilan, Rasht

(Received: 20/1/2009, in revised form: 5/7/2009)

**Abstract:** CdS: Mn nanocrystals were obtained by nucleation and growth in colloidal solution. Their mean size range between 3.96 nm and 4.90 nm. The structural properties were studied by the use of X-ray diffraction (XRD). Phase transition between the hexagonal structure and cubic structure was evidenced to be a function of synthesis temperature. The mechanism of the phase transition also was revealed by two-step annealing for 2h.

Keywords: CdS: Mn, semiconductor nanocrystal, annealing, phase transition



سال هفدهم، شمارهٔ ۴، زمستان ۸۸، از صفحهٔ ۶۲۱ تا ۶۲۸



# اثر دما و بازپخت بر خواص ساختاری نانو بلورهای نیمرسانای CdS:Mn

صديقه سليميان\*، صابر فرجامى شايسته

آزمایشگاه نانو ساختار، گروه فیزیک، دانشکدهٔعلوم پایه دانشگاه گیلان، رشت

(دریافت مقاله: ۸۷/۱۱/۱ ، نسخه نهایی: ۸۸/۴/۱۵ )

چکیده: نانو بلورهای CdS:Mn طی فرایندهای رشد و جوانه زنی در محلول کلوئیدی ساخته شدند. اندازهٔ اپتیکی نانوذرات تهیه شده در گسترهٔ ۳٬۹۶nm تا ۴٬۹nm قرار دارند. خواص ساختاری نانو ذرات با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. گذار فاز بین ساختار ششگوشی و مکعبی به صورت تابعی از دمای ستنز رخ داد. سازوکار گذار فاز بلوری در اثر فرآیند بازپخت دو ساعته و دو مرحلهای نیز مشاهده شد.

واژههای کلیدی: نانوبلور نیمرسانا، باز پخت، گذار فاز، CdS:Mn.

#### مقدمه

نانوبلورهای نیمرسانا به واسطهٔ اثر محدودیت کوانتومی و افزایش سطح به حجم، خواص فیزیکی منحصر به فردی مانند پهن شدگی گاف نواری، اثر اپتیکی غیر خطی [۲،۱] و افزایش بازده نورتابی از خود نشان میدهند. اغلب سرشتیهای نانو ذرات به اندازهٔ آنها وابسته است [۴،۳]، بنابراین تولید نانو نزرتابی با توزیع اندازهٔ یکسان از اهمیت ویژهای برخوردار است. نورتابی نانوبلورهای نیمرساناه ویژه نیمرساناهای گروه II-IV به دلیل ویژگیهای فیزیکی منحصر به فرد و کاربرد آنها در اپتوالکترونیک، در دههٔ اخیر بسیار مورد بررسی قرار گرفتهاند. البته خواص اپتیکی نانوبلورها را میتوان با کنترل اندازهٔ ذرات با توزیع اندازهٔ تقریبا یکسان، و یا آلایش با یونهای نورتاب کنترل کرد. آلایش نانوبلورهای ZnS و CdS مورد بررسی قرار گرفتهاند. نانوبلورها، نورتابی، نوارهای گسیل پهن و باریک و پایداری فوتوشیمیایی بهتری در قیاس با رنگینههای آلی دارند.

یونهای آلاینده در نانوبلورها به صورت مراکز بازترکیب برای زوج الکترون-حفرهٔ برانگیخته عمل میکنند و انتظار میرود که بازده کوانتومی به دلیل همپوشانی بیشتر بین الکترون و حفره با ترازهای جایگزیدهٔ آلاینده در مادهٔ نیمرسانای میزبان، افزایش یافته و از این پتانسیل میتوان در اپتیک غیر خطی، نور تابی، الکترونیک و قطعات اپتوالکترونیکی استفاده کرد. نورتابی مشاهده شده در نقطههای کوانتومی Mn2 با سازوکار انتقال انرژی صورت میپذیرد. بهطور کلی در آلایش و گذار نیمرسانا با گاف نواری مستقیم، گذار درونی درون مدار-های db. <sup>+2</sup>M با فرآیند انتقال انرژی جفت شده است. فوتولومینسانس <sup>+2</sup>M با گسیل از حالت برانگیختهٔ  $T^{4}$  به حالت پایهٔ  $f^{4}_{1}$  ایجاد شده است. و موقعیت نوار به شدت به شبکهٔ میزبان وابسته است. یونهای منگنز در بعضی جایگاههای

ً نویسنده مسئول، تلفن: ۳۲۲۳۱۳۲ (۱۳۱) ۹۸+، نمابر: ۳۲۲۰۰۶۶ (۱۳۱) ۹۹+، پست الکترونیکی: saber@guilan.ac.ir

بلوری، جداشدگی میدان- بلوری متفاوتی بین حالتهای مدار نشان میدهند. مشارکت  $Mn^{2+}$  درشبکهٔ CdS احتمال 3dبازترکیب غیر تابشی را کاهش میدهد و در نتیجه گسیل افزایش مییابد. بسیاری از پژوهشهای اخیر در  ${}^4T_1 
ightarrow {}^6A_1$ رابطه با بهره برداری فناوری از این مواد است، بنابراین کنترل سنتز مواد با خواص ساختاری مناسب مانند ساختار بلوری، اندازهٔ میانگین ذره و توزیع اندازه ذرات از اهمیت ویژهای برخورداراست. دستیابی به آگاهیهای در موارد مربوط به خواص فیزیکی خوشهها مانند، نقایص، ریختشناسی و سطح نانوذرات قابل توجه است. به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم [۷-۵] با کاهش اندازهٔ نانوذرات، نه تنها سطوح نانوذرات در مرحلهٔ جوانهزنی و رشد نقش مهمی دارند، بلکه در تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی ماده نیز مهماند. واکنش شیمیایی در دمای بالا (اثر بازپخت گرمایی)، نقایص بلوری نانوذرات را که می توانند به عنوان تله نور تابی را کاهش دهند، تا اندازهای بر طرف مى كند. نكتهٔ قابل توجه آن است كه دماى بالا، ناخالصى-ها را به سمت سطح نانوذرات منتشر و آنها را نزدیک سطح توزيع مي كند [۶، ۸]. واكنش گرمايي باعث افزايش و پهن-شدگی توزیع اندازهٔ نانوذرات میشود، بنابر محدود گزارشهای ارائه شده فاز بلوری نانوبلورهای CdS:Mn در دمای اتاق ششگوشی و در دماهای بالاتر مکعبی است [۹-۱۱] . در این کار پژوهشی به بررسی اثر دمای سنتز و اثر بازیخت گرمایی روى فاز بلورى و اندازهٔ نانوذرات آلائيده پرداختهايم.

# روش کار

نانوذرات CdS آلاییده به منگنز با استفاده از روش سنتز شیمیایی مرطوب با پیش مادههای CdCl<sub>2</sub>، 2MnCl و Na<sub>2</sub>S تهیه شده از شرکت Merck تولید شدهاند. در فرایند رشد از TG تهیه شده از شرکت Fluka برای کنترل رشد نانوذرات استفاده شد. در این کار پژوهشی از مواد اولیه با غلظت 0.1M و Hq اولیهٔ محیط ۲ برای آلایش نانوذرات CdS با یونهای منگنز استفاده شد. در این شرایط واکنشهای مازاد و امکان تشکیل بالای MnS محیط کاهش یافته و شرایط مناسبی برای آلایش نانوذرات CdS به وجود می آید. برای بررسی اثر دما در

طول سنتز در چیدمان واکنش از بازتابگر استفاده کردیم. برای بررسی تغییرات اندازهٔ نانو ذرات با گذر زمان حین سنتز، طیف جذبی نمونههای تولید شده هر یک ساعت یک بار تا پایان سنتز، دستگاه UV-Vis Cary 100 Scan مورد استفاده قرار گرفت. سنتز نانوذرات تولید شده با آلایش Mn % و در سه دمای ، اتاق (۲۷°c)،  $\Delta$  و  $\Delta$   $\Delta$  C انجام TG=./1 M شد. در پایان، پس از خشک کردن ته نشست حاصل از سنتز در هوا، پودر تهیه شده، طی فرآیند دو مرحلهای تحت بازپخت شد. فرایند بازپخت با کورهٔ ساخته شده در گروه انجام گرفت. نخست دمای پودر نانوذرات CdS:Mn در طول یک ساعت به ۰۲ ۲۰۰ رسید و نیم ساعت در این دما نگه داشته شد، و در مرحلهٔ بعد دما تا <sup>°</sup>C ۳۰۰ بالا رفت و نیم ساعت نیز در این دما باقی ماند. سپس سردایش به آرامی صورت گرفت. طیف XRD نمونهها به وسيلهٔ دستگاه Philip-pw-1830 با منبع برانگختگی Co با طول موج Å ۱٬۷۸۸۹۶ پیش و پس از بازپخت دریافت شد. و مورد بررسی قرار گرفت.

## بحث و بررسی

واکنش گرمایی میتواند باعث افزایش و پهنشدگی توزیع اندازهای نانو ذرات شود، بنابراین تغییر دما موجب کاهش خواص نورتابی نانو بلورها می شود. به دلیل باریکی توزیع اندازه-ای نانو ذرات که در طیف جذب نمونههای تهیه شده با آلائیدگی %۳ مشاهده شد، برای بررسی اثر تغییرات دما از نمونههای با این میزان آلائیدگی مورد استفاده قرار گرفت تا پهن شدگی توزیع اندازهای نانوذرات به کمینه برسد. در شکل ۱ طیف جذبی نمونههای B ، A و C را که به ترتیب در دمای اتاق( C °C )، C °C و ۲۶°C تهیه شدهاند، نشان میدهد. طیف جذبی نمونهها با افزایش دما یک جابه جائی با طول موج بزرگتر (حدود چند نانومتر) را مطابق شکل ۱ نشان میدهد. این جابه جائی بیانگر آن است که با افزایش دما، گاف انرژی کاهش و اندازهٔ نانوذرات افزایش یافته است. لازم به یادآوری است که، با افزایش درصد آلائیدگی و جانشینی یونهای منگنز به جای یونهای کادمیم در دمای اتاق فاز ششگوشی پایدار مى ماند [11] اما اندازة نانو ذرات كاهش مى يابد.



شکل ا طیف جذبی نمونه های نانو ذرات CdS:Mn با آلائیدگی %۳ تهیه شده در دمای: A) اتاق ( ۲۷°C)، B ۲= ۵۴ °C و T= ۵۴ °C او ۲

نواری شده است. بهطوری که اندازهٔ نانوذرات در ساعت اول برای نمونهٔ B از ۳/۵۷ به ۳/۶۹ نانومتر در ساعت ششم سنتز رسیده است و این مقدار برای نمونهٔ C از ۳/۶۹ به ۹۴ /۳ نانومتر رسید. یک توصیف کمی از اثر اندازهٔ کوانتومی بر مبنای رهیافت تقریب جرم موثر توسط Brus [۱۲] ارائه شده است: شکل های ۲ و ۳ به ترتیب طیف جذبی ساعت به ساعت نمونه-های B و C در دمای بالاتر از دمای اتاق در طول سنتز را نشان میدهد. تغییر اندازهٔ نمونههای B و C در طول سنتز، با زمان در شکلهای ۴ و ۵ ارائه شده است. چنانکه دیده میشود افزایش زمان در کل باعث افزایش اندازهٔ نانوذرات و کاهش گاف

$$E_{g(np)} = E_{g(bulk)} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2R^2} \left[ \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right] - \frac{1.8e^2}{\epsilon R} - 0.248E_{Ry}^*$$
(1)

CdS )، ٤ پذیرفتاری الکتریکی محیط و  $E^*_{Ry}$  انرژی ریدبرگ اکسیتون است. با استفاده از رابطه ۱ اندازهٔ نانوذرات براورد شده است.

که در آن (E<sub>g(bulk</sub>) ، CdS:Mn گاف انرژی نانو بلور E<sub>g(bulk</sub>) ، CdS:Mn گاف انرژی CdS کپهای، R شعاع نانوذرات، m<sub>e</sub> جرم موثر الکترون ( ۱۹ m<sub>o</sub> برای CdS)، m<sub>h</sub> جرم موثر حفره (۸۰ m<sub>o</sub>، برای



شکل ۲ طیف جذبی ساعت به ساعت نمونهٔ B با گذر زمان سنتز



شکل ${\mathbb T}$  طيف جذبي ساعت به ساعت نمونهٔ C با گذر زمان سنتز.



شکل۴ تغییران گاف نواری واندازهٔ ذرات نمونهٔ B تهیه شده در دمای ۵۴  $^{
m o}$ ۵۴، با گذر زمان سنتز.



شکل $\Delta$  تغییرات گاف نواری و اندازهٔ ذرات نمونهٔ C تهیه شده در دمای  $^{\circ}C$  ۷۶، با زمان سنتز.

با بررسی ساختاری نانوذرات تهیه شده با توجه به شکل ۶، معلوم شد که افزایش دمای سنتز از نمونهٔ A به B و از نمونهٔ B به C فاز از ششگوشی به سمت فاز مکعبی [۹–۱۱] جابه جا شده است، به طوری که اثر فاز ششگوشی مشاهده شده در زاویهٔ ۵۲<sup>۵</sup> جزئی است. جدول ۱ تغییر اندازهٔ نانوذرات با افزایش دما را که با استفاده از فرمول دبای شرر براورد شده است  $d = \frac{0.94\lambda}{2}$ 

$$I = \frac{1}{FWHM(2\Theta).Cos\Theta}$$
(2)

در این رابطه d شعاع بلورکها،  $\lambda$  طول موج پرتو x تابشی، FWHM(2 $\Theta$  پهنای نیم بیشینه و  $\Theta$  زاویه پراکندگی است. تغییر فاز و اندازه نانوذرات با دما در جدول ۱ ارائه شده است. با توجه به اینکه شعاع نانو ذرات از اندازهٔ ۲ نانومتر بیشتر است فاز بلوری نانو ذرات تقریبا پایدار بوده است.

بررسی فرایند بازپخت با توجه به شکل ۷ نشان میدهد که بازپخت نمونهٔ A موجب پیدایش فاز مکعبی شده است. در بازپخت نمونههای A و B ، علاوه بر گذار فاز بلوری، افزایش

بلورینگی در دسته صفحات اصلی فاز مکعبی (صفحات (۱۱۱)، (۲۲۰) و (۳۱۱) بهترتیب در زوایای ۸۸٬۳۸، ۵۱٬۴۷ و ۶۱٬۱۰) مشاهده می شود. افزایش اندازهی ذرات در جدول ۲ آمده است. چنانکه شکل γ نشان میدهد، نمونهٔ B دستخوش جابه جایی فاز بلوری به فاز مکعبی شده است و قله مشاهده شده در ۵۷ درجه گویای حضور یکی از دسته صفحات اصلی فاز ششگوشی (صفحه (۱۰۳)) است. بازیخت نمونهٔ یادشده تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد موجب کاهش اندازهٔ بلورک و افزایش بلورینگی فاز مکعبی شده است. فاز ششگوشی موجود در نمونهٔ B با فرآیند بازیخت از بین نرفته است و همچنان حضور دارد و کاهش پهنای قله مربوط به آن گویای کاهش اندازهٔ بلورکهای موجود در این فاز است. مقایسهٔ بازیخت نمونههای A و B نشان می-دهد که بازیخت نمونهٔ A موجب گذار فاز بلوری وافزایش بلورینگی در فاز جدید و افزایش اندازهٔ بلورکها شده است، ولی شدت بلورینگی حاصل از بازیخت نمونهٔ  ${
m B}$  نسبت به نمونهٔ بازیخت شدهٔ A کمتر است.



**شکل**۶ طرح پراش نمونهٔ: A تهیه شده در دمای اتاق( <sup>C</sup> ۲۷)، نمونهٔ B در دمای <sup>C</sup> ۲۴ =T و نمونهٔ C در دمای <sup>C</sup> ۲۶ T= گذار فاز بلوری از ششگوشی به مکعبی از A تا C بهخوبی دیده میشود.

| جدول، تعییر الماره و قار بلوری با توجه به تعییر دمای سند. |                     |               |                |  |
|---|---------------------|---------------|----------------|--|
| نام نمونه   | اندازہ ی بلورک (nm) | دمای سنتز(°C) | فاز بلورى غالب |  |
| A   | ١,٢٨                | ۲۷            | هگزاگونال      |  |
| В   | ۲٫۴۳                | ۵۴            | مكعبى          |  |
| С   | ٣,١                 | ٧۶            | مكعبى          |  |

فا ياء اندا: م \_ 7.1 . - 1 Io.so . .



شکل V الگوی پراش نمونههای A و B پیش و پس از بازیخت نمونهها.

| نام نمونه   | اندازه ی بلور ک(nm) | دما C° | فاز بلورى غالب |
|-------------|---------------------|--------|----------------|
| А           | ١,٢٨                | ۲۷     | هگزاگونال      |
| Annealing A | ٣,• ٧               | ۳۰۰    | مكعبى          |
| В           | ۲,•۴                | ۵۴     | مكعبى          |
| Annealing B | ٣٫۵٣                | ۳۰۰    | مكعبى          |

جدول ۲ تغییر اندازهٔ نانوذرات بر اثر بازپخت نمونهای A و B.

[2] M. Pattabi, B. S. Amma, "Solar Energy Materials &Solar Cells", 90 (2007) 2377-2383.
[3] S. Jamali, E. S. Irani Zad, S. Farjami

[3] S. Jamali, E. S. Irani Zad, S. Farjami Shayesteh, "*Metal-Organic and Nano- Metal Chemistry*", 37 (2007) 1-6.

[4] S. Jamali, E. S. Irani Zad, S. Farjami Shayesteh, International J., "*Nanoscience and Nanotechnology 3*", (2007) 53-58.

[5] P. S. Chowdhury et al. Journal of Luminescence 124 (2007) 327-332.

[6] Semiconductor and Metal Nanocrystals, edited by Victor I. Klimov (Marcel Decker, New York, 2004).

[7] Angshuman Nag, Sameer Sarpa, C. Nagamani, Ajay sharma, N. Pradhan, Chem. Matter. 19 (2007) 3252-3259.

[8] Y. Kanemitsu, A. Ishizumi, Journal of Luminescence 119-120 (2006) 161-166.

[9] M. Marandi, N. Taghavinia, Z. Sedaghat, A. Irajizad, S. M.Mahdavi, Nanotechnology 19(2008) 225705.

[10] Z. Sedaghat, N. Tghavinia, M. Marandi, Nanotechnology 17 (2006) 3812-3816.

[11] B. Tripathi, F. Singh, D. K. Avasthi, D. Das, Y. K. Vijay, Physica B 400 (2007) 70-76

[12] L. E Brus, J. Chem. Phys. 90, (1986) 2555-2560.

برداشت

بررسی تغییر طیف جذب حین سنتز نانوذرات CdS:Mn نشان میدهد که، افزایش دما موجب انتقال به سرخ (در حد چند نانومتر) طول موج جذب نانوذرات شده است. می توان گفت با گذر زمان حین سنتز، دما تاثیر چندانی بر اندازهٔ نانوذرات نداشته است. از مقایسهٔ الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات، تهیه شده در دماهای اتاق (۲۷°C)، ۵۴°C و ۷۶°C، مشخص می-شود، که افزایش دما هنگام سنتز نانوذرات، موجب جابه جایی فاز بلوری از ششگوشی به مکعبی شده است. در این جابه جایے، فاز بلوري غالب فاز مكعبي است، ولي همزمان قلهٔ مربوط به فاز بلوری ششگوشی نیز با شدت کمتری مشاهده میشود. باز یخت نمونهٔ تهیه شده در دماهای بالاتر از دمای اتاق با حفط دسته صفحات مشاهده شده، مربوط به هر دو فاز حاضر ششگوشی و مکعبی موجود در نمونه پیش از بازپخت، باعث افزایش بلورینگی فاز مکعبی شده و اندازهٔ نانوذرات کاهش یافته است. در بازیخت نمونهٔ سنتز شده در دمای اتاق، علاوه برجابه جایی به فاز مکعبی و افزایش اندازهٔ نانوذرات، شاهد افزایش بلورینگی در فاز جدید نیز خواهیم بود.

#### مراجع

[1] K. K. Nanda, "Solid State Communications 111", (1999) 671-674.